

January 7, 1998

TEL:805-498-2111 FAX:805-498-3804 WEB:http://www.semtech.com

AXIAL LEADED HERMETICALLY SEALED SUPERFAST RECTIFIER DIODE

- Very low reverse recovery time
- Hermetically sealed in Metoxilite fused metal oxide
- Low switching losses
- Low forward voltage drop
- Soft, non-snap off, recovery characteristics

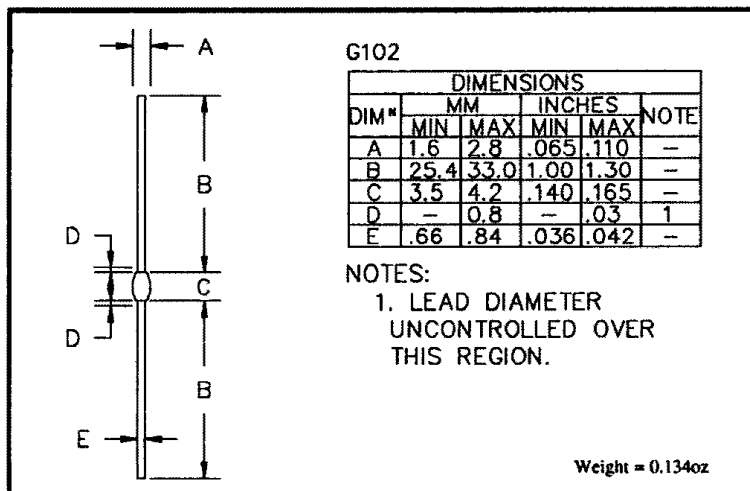
QUICK REFERENCE DATA

- $V_R = 50 - 150V$
- $I_F = 3.1A$
- $t_{rr} = 30ns$
- $V_F = 1.2V$

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (@ 25°C unless otherwise specified)

	Symbol	1N6076 3FF05	1N6077 3FF10	1N6078 3FF15	Unit
Working reverse voltage	V_{RWM}	50	100	150	V
Repetitive reverse voltage	V_{RRM}	50	100	150	V
Average forward current (@ 55°C, lead length = 0.375")	$I_{F(AV)}$	←	3.1	→	A
Repetitive surge current (@ 55°C in free air, lead length 0.375")	I_{FRM}	←	14.0	→	A
Non-repetitive surge current ($t_p = 8.3ms$, @ V_R & T_{jmax})	I_{FSM}	←	70.0	→	A
Storage temperature range	T_{STG}	←	-65 to +150	→	°C
Operating temperature range	T_{OP}	←	-65 to +150	→	°C

MECHANICAL



These products are qualified to MIL-S-19500/503.

They can be supplied fully released as JAN, JANTX, and JANTXV versions.

January 7, 1998

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (@ 25°C unless otherwise specified)

	Symbol	1N6076 3FF05	1N6077 3FF10	1N6078 3FF15	Unit
Average forward current max. (pcb mounted; T _A = 55°C) for sine wave	I _{F(AV)}	←----- 1.30 -----→			A
for square wave (d = 0.5)	I _{F(AV)}	←----- 1.40 -----→			A
Average forward current max. T _L = 70°C; L = 0". T _L = 55°C; L = 3/8"	I _{F(AV)}	←----- 6.0 -----→			A
for sine wave	I _{F(AV)}	←----- 3.0 -----→			A
for square wave	I _{F(AV)}	←----- 3.1 -----→			A
I ² t for fusing (t = 8.3ms) max.	I ² t	←----- 5.1 -----→			A ² S
Forward voltage drop max. @ I _F = 3.0A, T _j = 25°C	V _F	←----- 1.2 -----→			V
Reverse current max. @ V _{RWM} , T _j = 25°C	I _R	←----- 5.0 -----→			µA
@ V _{RWM} , T _j = 100°C	I _R	←----- 100 -----→			µA
Reverse recovery time 0.5A I _F to 1.0A I _R . Recovers to 0.25A I _{RR} .	t _{rr}	←----- 30 -----→			nS
Junction capacitance typ. @ V _R = 5V, f = 1MHz	C _j	←----- 60 -----→			pF

THERMAL CHARACTERISTICS

	Symbol	1N6076 3FF05	1N6077 3FF10	1N6078 3FF15	Unit
Thermal resistance - junction to lead Lead length = 0.0"	R _{θJL}	←----- 8.5 -----→			°C/W
Lead length = 0.375"	R _{θJL}	←----- 25 -----→			°C/W
Thermal resistance - junction to amb. on 0.06" thick pcb. 1 oz. copper.	R _{θJA}	←----- 90 -----→			°C/W



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.